

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2020 年 9 月 3 日 (03.09.2020)



(10) 国际公布号
WO 2020/172945 A1

(51) 国际专利分类号:
H01L 51/50 (2006.01) *H01L 51/56* (2006.01)
H01L 51/52 (2006.01) *H01L 27/32* (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2019/080870

(22) 国际申请日: 2019 年 4 月 1 日 (01.04.2019)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201910144112.7 2019 年 2 月 27 日 (27.02.2019) CN

(71) 申请人: 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司(SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号, Guangdong 518132 (CN)。

(72) 发明人: 吴元均(WU, Yuanchun); 中国广东省深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号, Guangdong

518132 (CN)。袁伟(YUAN, Wei); 中国广东省深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号, Guangdong 518132 (CN)。 矫士博(JIAO, Shibo); 中国广东省深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号, Guangdong 518132 (CN)。

(74) 代理人: 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙)(ESSEN PATENT & TRADEMARK AGENCY); 中国广东省深圳市福田区深南大道6021号喜年中心A座1709-1711, Guangdong 518040 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) **Title:** BOTTOM-EMITTING WHITE ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE (WOLED) AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND DISPLAY DEVICE

(54) 发明名称: 底发射白光有机发光二极管(WOLED)及其制作方法、显示装置

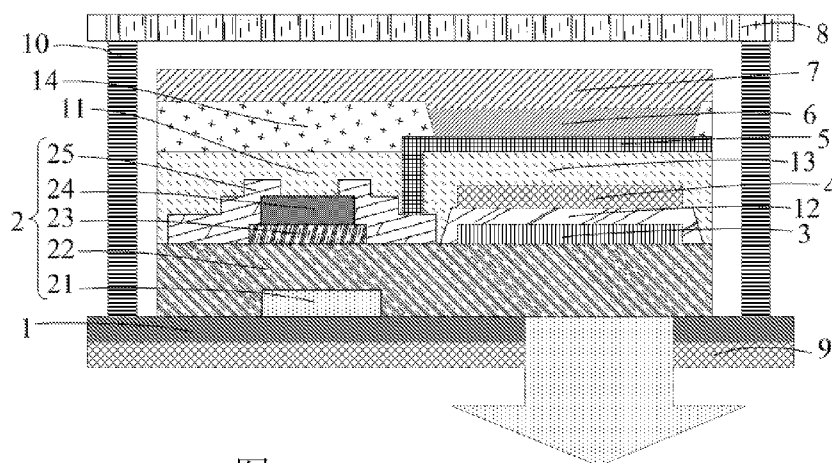


图 1

(57) **Abstract:** A bottom-emitting WOLED display panel, comprising a substrate, a thin film transistor, a WOLED color film layer, a quantum dot photoluminescence conversion layer, a first electrode, a WOLED electroluminescent function layer and a second electrode. The WOLED color film layer is sequentially provided with red, green, blue and white pixels. The quantum dot photoluminescence conversion layer comprises a quantum dot red and green luminescent material provided corresponding to the red and green pixels. The WOLED electroluminescent function layer is provided on the first electrode. The second electrode is provided on the WOLED electroluminescent functional layer, and blue light or yellow light of the WOLED electroluminescent function layer is converted into red light and green light by means of the quantum dot red and green luminescent material of the quantum dot photoluminescence conversion layer.



WO 2020/172945 A1



SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要: 一种底发射WOLED显示面板包括基板、薄膜晶体管、WOLED彩膜层、量子点光致转换层、第一电极、WOLED电致发光功能层及第二电极。WOLED彩膜层依次设置红绿蓝白像素。量子点光致转换层包括对应所述红绿像素设置的量子点红绿发光材料。WOLED电致发光功能层设置在所述第一电极上。第二电极设置在所述WOLED电致发光功能层上, 通过所述量子点光致转换层的所述量子点红绿发光材料将所述WOLED电致发光功能层的蓝光或黄光转换成红光和绿光。

底发射白光有机发光二极管(WOLED)及其制作方法、显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种显示技术领域，尤其是涉及一种底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板及其制作方法、显示装置。

背景技术

[0002] 有机电致发光二极管(OLED)是一种新型显示技术，与LCD显示技术相比，具有主动发光，色彩真实，无限对比度，零延迟，透明显示、柔性显示、自由形态显示(Free-Form Display)等特性，是可以替代液晶显示技术的下一代显示技术。OLED显示技术由于不需要背光源，结构较LCD更为简单，显示产品体积可以做到更轻薄。在大尺寸面板显示技术中主要应用的是白光有机发光二极管(WOLED)，WOLED技术区别于广泛应用于小尺寸的并排(side-by-side)RGB技术，最大优势是在制程中不需要精细金属掩模板(FMM, fine metal mask)，因此可以大幅降低设备成本。

[0003] 然而现有的WOLED主要利用蓝色+黄色(BY)或蓝色+红色+绿色(BGR)等两叠层或三叠层结构实现白光。由于白光光谱较宽，利用彩色滤光片(CF)将白光分离成RGB三基色时，RG光谱通常较宽，色纯度较低，面板色域表现难以突破NTSC(美国电视标准委员会)制定的100%标准。此外，白光分离成RG光谱时，仅能利用白光光谱中较少的红光或绿光部分，蓝光及黄光部分能量损失较大。因此现有的WOLED由于能量利用率较低，将造成面板工作时功耗较高的问题。

发明概述

技术问题

[0004] 然而现有的WOLED主要利用蓝色+黄色(BY)或蓝色+红色+绿色(BGR)等两叠层或三叠层结构实现白光。由于白光光谱较宽，利用彩色滤光片(CF)将白光分离成RGB三基色时，RG光谱通常较宽，色纯度较低，面板色域表现难以突破NTSC(美国电视标准委员会)制定的100%标准。此外，白光分离成RG光谱时，仅能利

用白光光谱中较少的红光或绿光部分，蓝光及黄光部分能量损失较大。因此现有的WOLED由于能量利用率较低，将造成面板工作时功耗较高的问题。

问题的解决方案

技术解决方案

- [0005] 本发明提供一种底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板及其制作方法、显示装置，利用量子点光致转换层内的光致发光特性将WOLED电致发光功能层中的蓝白光转换成红光或绿光，以增强显示面板对WOLED电致发光功能层的能量利用效率，同时提高显示面板的色域表现，并降低显示面板的功耗。
- [0006] 为达成本发明的前述目的，本发明提供一种底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，包括基板、薄膜晶体管、WOLED彩膜层(WOLED-CF)、量子点光致转换层、第一电极、WOLED电致发光功能层及第二电极。薄膜晶体管设置在所述基板上，在所述薄膜晶体管上设置第一保护层以保护所述薄膜晶体管结构。WOLED彩膜层(WOLED-CF)设置在所述第一保护层上，所述WOLED彩膜层依次设置红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层上设置第二保护层。量子点光致转换层，设置在所述第二保护层上。所述量子点光致转换层包括对应所述红绿(RG)像素设置的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层上设置树脂层或平坦层。第一电极设置在所述树脂层或所述平坦层薄膜晶体管上，并在所述第一电极上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域。WOLED电致发光功能层设置在所述第一电极上并对应所述量子点光致转换层设置。第二电极设置在所述WOLED电致发光功能层上，其中通过所述量子点光致转换层的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料将所述WOLED电致发光功能层的蓝光或黄光转换成红光和绿光，从而提升所述红色像素和所述绿色像素的亮度。
- [0007] 根据本发明一实施例，所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料对应所述WOLED彩膜层的所述红绿(RG)像素设置，而所述WOLED彩膜层的所述蓝白(BW)像素对应所述量子点光致转换层为空白，其中所述量子点光致转换层为量子点增强薄膜(QD-EF)。
- [0008] 根据本发明一实施例，所述WOLED电致发光功能层包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合，所述WOL

ED电致发光功能层包含2叠层或3叠层结构，且为正置或倒置结构。

[0009] 根据本发明一实施例，所述WOLED电致发光功能层包括空穴注入层(HIL: HATCN)、空穴传输层(HTL: NPB)、蓝色发光层(B-EML: FIrpic)、电荷传输层(TPBi)、电荷产生层(BPhen:Li)、空穴产生层(HATCN)、黄光发光层(Y-EML: PO-48)和电荷注入层(Liq)。

[0010] 根据本发明一实施例，还包括防护玻璃(CG)及封装材料，所述防护玻璃盖设在所述第二电极上方，所述封装材料贴合并封装所述基板和所述防护玻璃，所述封装材料与所述WOLED电致发光功能层、所述量子点光致转换层和所述防护玻璃垂直，所述薄膜晶体管还包括栅极、层叠在所述栅极上的栅极绝缘层、有源层、绝缘遮蔽层以及源漏极，所述第一保护层设置在所述源漏极上，其中所述第一保护层为树脂材料，及所述薄膜晶体管为底栅(BG)TFT结构。

[0011] 根据本发明一实施例，所述薄膜晶体管还包括设置在所述基板上的遮蔽层、缓冲层、有源层、栅极绝缘层、栅极、层间绝缘层以及源漏极，所述第一保护层设置于所述层间绝缘层上且以氧化硅(SiO_x)作为钝化层，及所述薄膜晶体管为双栅(DG)TFT结构。

[0012] 根据本发明一实施例，所述第一电极上还设置有空白层或像素限定层，所述空白层或所述像素限定层邻接所述WOLED电致发光功能层。

[0013] 本发明还提供一种显示装置，包括：

[0014] 基板；

[0015] 薄膜晶体管，设置在所述基板上，在所述薄膜晶体管上设置第一保护层以保护所述薄膜晶体管内部结构；

[0016] WOLED彩膜层(WOLED-CF)，设置在所述第一保护层上，所述WOLED彩膜层依次设置红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层上设置第二保护层；

[0017] 量子点光致转换层，设置在所述第二保护层上，所述量子点光致转换层包括对应所述红绿(RG)像素设置的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层上设置树脂层或平坦层；

[0018] 第一电极，设置在所述树脂层或所述平坦层上，并在所述第一电极上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域；

- [0019] WOLED电致发光功能层，设置在所述第一电极上并对应所述量子点光致转换层设置；
- [0020] 第二电极，设置在所述WOLED电致发光功能层上，其中通过所述量子点光致转换层的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料将所述WOLED电致发光功能层的蓝光或黄光转换成红光和绿光，从而提升所述红色像素和所述绿色像素的亮度，及
- [0021] 偏光层，设置在所述基板的另一侧面上。
- [0022] 根据本发明一实施例，所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料对应所述WOLED彩膜层的所述红绿(RG)像素设置，而所述WOLED彩膜层的所述蓝白(BW)像素对应所述量子点光致转换层为空白，其中所述量子点光致转换层为量子点增强薄膜(QD-EF)。
- [0023] 根据本发明一实施例，所述WOLED电致发光功能层包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合，所述WOLED电致发光功能层包含2叠层或3叠层结构，且为正置或倒置结构。
- [0024] 根据本发明一实施例，所述WOLED电致发光功能层包括空穴注入层(HIL: HATCN)、空穴传输层(HTL: NPB)、蓝色发光层(B-EML: Flrpic)、电荷传输层(TPBi)、电荷产生层(BPhen:Li)、空穴产生层(HATCN)、黄光发光层(Y-EML: PO-48)和电荷注入层(Liq)。
- [0025] 根据本发明一实施例，还包括防护玻璃(CG)及封装材料，所述防护玻璃盖设在所述第二电极上方，所述封装材料贴合并封装所述基板和所述防护玻璃，所述封装材料与所述WOLED电致发光功能层、所述量子点光致转换层和所述防护玻璃垂直，所述薄膜晶体管还包括栅极、层叠在所述栅极上的栅极绝缘层、有源层、绝缘遮蔽层以及源漏极，所述第一保护层设置在所述源漏极上，其中所述第一保护层为树脂材料，及所述薄膜晶体管为底栅(BG)TFT结构。
- [0026] 根据本发明一实施例，所述薄膜晶体管还包括设置在所述基板上的遮蔽层、缓冲层、有源层、栅极绝缘层、栅极、层间绝缘层以及源漏极，其中所述第一保护层设置于所述层间绝缘层上且以氧化硅(SiO_x)作为钝化层，及所述薄膜晶体管为双栅(DG)TFT结构。

- [0027] 根据本发明一实施例，所述第一电极上还设置有空白层或像素限定层，所述空白层或所述像素限定层邻接所述WOLED电致发光功能层。
- [0028] 再者，本发明还提供底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，包括以下步骤：
- [0029] S10、提供基板；
- [0030] S20、在基板上制作形成所述薄膜晶体管，以及在所述薄膜晶体管上形成第一保护层；
- [0031] S30、在所述第一保护层上形成WOLED彩膜层(WOLED-CF)，所述WOLED彩膜层依次形成红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层上形成第二保护层；
- [0032] S40、在所述第二保护层上形成量子点光致转换层(QD-PL conversion layer)，所述量子点光致转换层包括对应所述红绿(RG)像素填充的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层上形成树脂层或平坦层；
- [0033] S50、在所述树脂层或平坦层上形成第一电极，并在所述第一电极上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域；
- [0034] S60、在所述第一电极上形成WOLED电致发光功能层并对应所述量子点光致转换层设置；及
- [0035] S70、在所述WOLED电致发光功能层上形成第二电极，其中通过所述量子点光致转换层的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料将所述WOLED电致发光功能层的蓝光或黄光转换成红光和绿光，从而提升所述红色像素和所述绿色像素的亮度。
- [0036] 根据本发明一实施例，在步骤S40中，所述量子点光致转换层通过喷墨打印、喷嘴印刷或转移成型工艺制成，所述量子点光致转换层还将量子点红绿(QD-R&G)发光材料填充在相应的红绿(RG)像素区域中，所述量子点红绿发光材料则不填充于蓝白(BW)像素区域中，所述量子点光致转换层为量子点增强薄膜，且厚度为10-200奈米(nm)。
- [0037] 根据本发明一实施例，在步骤S60中，所述WOLED电致发光功能层包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合。

合。

[0038] 根据本发明一实施例，在步骤S60后，在所述第一电极上还形成有空白层或像素限定层，所述空白层或所述像素限定层邻接所述WOLED电致发光功能层，并定义所述红绿蓝白(RGBW)像素区域。

[0039] 根据本发明一实施例，在步骤S30中，包括在所述薄膜晶体管上涂布树脂材料或沉积氧化硅并通过显影、曝光形成图案化，以形成所述第一保护层。

[0040] 根据本发明一实施例，在步骤S70后，还包括盖设在所述第二电极上方的防护玻璃(CG)以及贴合并封装所述基板和所述防护玻璃的封装材料，所述封装材料通过阻塞封装、阻塞填入封装、熔块封装、面密封封装或薄膜封装。

发明的有益效果

有益效果

[0041] 本发明在WOLED电致发光功能层和WOLED彩膜层之间增加一层量子点光致转换层，其中量子点光致转换层包含有机材料基质，不影响WOLED透明显示、柔性显示、显示形态自由等特性。量子点光致转换层能够将WOLED电致发光功能层中短波长部分的蓝光利用量子点发光材料的光致发光特性转换成红光或绿光，以增加显示面板对WOLED电致发光功能层的能量利用效率，同时提高显示面板的色域表现，并降低显示面板的功耗。

对附图的简要说明

附图说明

[0042] 为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0043] 图1为底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的横截面示意图；

[0044] 图2为本发明底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的另一横截面示意图；及

[0045] 图3为本发明底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法的方块图。

实施该发明的最佳实施例

本发明的最佳实施方式

- [0046] 在具体实施方式中提及“实施例”意指结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的不同位置出现的相同用语并非必然被限制为相同的实施方式，而应当理解为与其它实施例互为独立的或备选的实施方式。在本发明提供的实施例所公开的技术方案启示下，本领域的普通技术人员应理解本发明所描述的实施例可具有其他符合本发明构思的技术方案结合或变化。
- [0047] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语，例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]、[竖直]、[水平]等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以限制本发明。在图中，结构相似的单元是用以相同标号表示。
- [0048] 请参照图1所示，为本发明第一较佳具体实施例示意图。本发明提供一种底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，包括基板1、薄膜晶体管2、WOLED彩膜层(WOLED-CF)3、量子点光致转换层4、第一电极5、WOLED电致发光功能层6及第二电极7。所述基板1包含但不限于刚性基板、柔性基板或其他适合基板，其中柔性基板例如玻璃基板、聚酰亚胺基板等，并不限定。
- [0049] 薄膜晶体管2设置在所述基板1上，在所述薄膜晶体管2上设置第一保护层11以保护所述薄膜晶体管2内结构。WOLED彩膜层3(WOLED-CF)设置在所述第一保护层11上，所述WOLED彩膜层3依次设置红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层3上设置第二保护层12。量子点光致转换层4(QD-PL conversion layer)，设置在所述第二保护层12上。
- [0050] 所述量子点光致转换层4包括对应所述红绿(RG)像素设置的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层4上设置树脂层或平坦层13。第一电极5设置在所述树脂层或所述平坦层13上，并在所述第一电极5上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域。WOLED电致发光功能层6设置在所述第一电极5上并对应所述量子点光致转换层4设置。第二电极7设置在所述WOLED电致发光功能层6上，

其中通过所述量子点光致转换层4的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料(图略)将所述WOLED电致发光功能层6的蓝光或黄光转换成红光和绿光,从而提升所述红色像素和所述绿色像素的亮度,达到提升底发射WOLED显示面板的色域表现。

[0051] 所述量子点光致转换层4包含将所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料对应所述WOLED彩膜层3的所述红绿(RG)像素设置,而所述WOLED彩膜层3的所述蓝白(BW)像素对应所述量子点光致转换层4为空白,即所述量子点红绿发光材料不填充于蓝白像素区域中。本实施例的所述量子点光致转换层4优选为量子点增强薄膜(QD-EF, Quantum Dot Enhancement Film)。因此,本发明利用量子点光致转换层4内的量子点红绿(QD-R&G)发光材料的光致发光特性将WOLED电致发光功能层6中的蓝白光转换成红光或绿光,以增强显示面板对WOLED电致发光功能层6的能量利用效率,同时提高显示面板的色域表现,并降低显示面板的功耗。

[0052] 所述WOLED电致发光功能层6包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合。所述WOLED电致发光功能层6包含2叠层(2 stacks)、3叠层(3 stacks)或其它多叠层结构,且可为正置或倒置结构,均视需要而改变。

[0053] 所述WOLED电致发光功能层6还包括空穴注入层(HIL: HATCN)、空穴传输层(HTL: NPB)、蓝色发光层(B-EML: FIrpic)、电荷传输层(TPBi)、电荷产生层(BPhen:Li)、空穴产生层(HATCN)、黄光发光层(Y-EML: PO-48)和电荷注入层(Liq)。

[0054] 在如图1所示的实施例中,还包括盖设在所述第二电极7上方的防护玻璃8(CG)以及贴合并封装所述基板1和所述防护玻璃8的封装材料10(encapsulation material)。所述封装材料10与所述WOLED电致发光功能层6、所述量子点光致转换层4和所述防护玻璃8垂直。

[0055] 所述薄膜晶体管2还包括设置在所述基板1上的栅极21、层叠在所述栅极21上的栅极绝缘层22、有源层23、绝缘遮蔽层24以及源漏极25。所述第一保护层11设置在所述源漏极25上且所述第一保护层11优选为树脂层,从而实现保护所述薄

膜晶体管2各层的作用。所述第一电极5设置在所述树脂层上并与所述源漏极25电性连接。如图1所示的所述薄膜晶体管2例如为底栅(BG)TFT结构。

[0056] 请一并参照图2所示，为本发明第二具体实施例示意图。本实施例与上述实施例差异在于所述薄膜晶体管2'例如为双栅(DG)TFT结构。具体而言，所述薄膜晶体管2'还包括设置在所述基板1上的遮蔽层21'、层叠在所述遮蔽层21'的缓冲层22'、有源层23'、栅极绝缘层24'、栅极25'、层间绝缘层26'以及源漏极27。所述第一保护层11设置于所述层间绝缘层24'上且以氧化硅(SiO_x)作为钝化层，从而实现保护所述薄膜晶体管2'各层的作用。所述第一电极3设置在所述钝化层上并与所述源漏极25'电性连接。

[0057] 在第一和第二实施例中，所述第一电极5上还设置有空白层14 (图1)或像素限定层14 (图2)。所述空白层14或所述像素限定层14邻接所述WOLED电致发光功能层6。

[0058] 本发明还提供一种显示装置，包括设置在所述基板1另一侧面的偏光层9(polarizing layer)，及如上述实施例的所述底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板。所述偏光层9能够实现高亮度、高对比度的特性。有关显示装置的相关结构，请参上述实施例所述，在此不再赘述。

[0059] 请一并参照图3所示，为本发明底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法的方块图。如图所示，本发明还提供底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，包括以下步骤：S10、提供基板1；S20、在基板1上制作形成所述薄膜晶体管2、2'，以及在所述薄膜晶体管2、2'上形成第一保护层11；S30、在所述第一保护层11上形成WOLED彩膜层3(WOLED-CF)，所述WOLED彩膜层3依次形成红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层3上形成第二保护层12；S40、在所述第二保护层12上形成量子点光致转换层4(QD-PL conversion layer)，所述量子点光致转换层4包括对应所述红绿(RG)像素填充的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层4上形成树脂层或平坦层13；S50、在所述树脂层或平坦层13上形成第一电极5，并在所述第一电极5上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域；S60、在所述第一电极5上形成WOLED电致发光功能层6并对应所述量子点光致转换层4设置；及S70、在所述WOLED电致

发光功能层6上形成第二电极7，其中通过所述量子点光致转换层4的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料将所述WOLED电致发光功能层6的蓝光或黄光转换成红光和绿光，从而提升所述红光和所述绿光的亮度，并降低显示面板的功耗。

[0060] 在步骤S60后，在所述第一电极5上还形成有空白层14或像素限定层14。所述空白层14或所述像素限定层14邻接所述WOLED电致发光功能层6。在步骤S60中，所述WOLED电致发光功能层6包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合。所述WOLED电致发光功能层6能够包含2叠层、3叠层或多叠层结构，且为正置或倒置结构，视需要而改变。

[0061] 在步骤S70中，第二电极7的材料例如Ag，且厚度为100-200奈米(nm)。所述第二电极5在可见光区域中具有良好的光透过性。

[0062] 在步骤S40中，所述量子点光致转换层4通过喷墨打印(ink-jet printing)、喷嘴印刷(nozzle printing)或转移成型(transfer)制程工艺制成。所述量子点光致转换层4还将量子点红绿(QD-R&G)发光材料(图略)填充在相应的红绿(RG)像素区域中，所述量子点红绿发光材料则不填充于蓝白(BW)像素区域中，即对应所述蓝白(BW)像素区域的所述量子点红绿发光材料为空白(blank)。本实施例的量子点光致转换层4优选为量子点增强薄膜(QD-EF, Quantum Dot Enhancement Film)，且厚度为10-200奈米(nm)。

[0063] 在步骤S70后，还包括盖设在所述第二电极7上方的防护玻璃8(CG)以及贴合并封装所述基板1和所述防护玻璃8的封装材料10(encapsulation material)。所述封装材料10通过阻塞封装(Dam package)、阻塞填入封装(Dam&Fill package)、熔块封装(Frit package)、面密封封装(Face-seal package)或薄膜封装(TFE)等工艺将所述基板1和所述防护玻璃8进行贴合和封装。

[0064] 在步骤S20的一实施例中(图1)，所述薄膜晶体管2制备方式包括在基板1上依次沉积Al/Mo金属层，经由曝光、显影、刻蚀、剥膜(stripe)等工艺对金属层进行图案化，以形成栅极21。在栅极21上沉积SiOX作为栅极21的栅极绝缘层22(insulating gate layer)。栅极绝缘层22上沉积IGZO层(氧化铟镓锌, Indium Gallium Zinc Oxide)，经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对IGZO层进行图案化，形成有源层23。在有源层23之上沉积SiOX，经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对SiOX

进行图案化，形成绝缘遮蔽层24并对有源层23进行保护。在绝缘遮蔽层24上依次沉积Mo/Al/Mo金属层，经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对Mo/Al/Mo金属层进行图案化，形成源漏极25。在源漏极25上涂布树脂，再经由曝光、显影等工艺对树脂进行图案化，形成树脂层的第一保护层11并对各层起到钝化保护作用。

[0065] 在步骤S20的另一实施例(图2)中，在基板1上依次沉积Mo金属层，经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对Mo金属层进行图案化，形成遮蔽层15(shielding layer)。在遮蔽层15上沉积SiOX作为缓冲层16。在缓冲层16上沉积IGZO，经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对IGZO层进行图案化，形成有源层21'。在有源层21'之上沉积SiOX，形成栅极绝缘层22'并对有源层21'进行保护。在栅极绝缘层22'上依次沉积Mo/Al/Mo金属层，经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对Mo/Al/Mo金属层进行图案化，形成栅极23'。在栅极23'上沉积SiOX为层间绝缘层24'，再经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对层间绝缘层24'和缓冲层16进行图案化。在层间绝缘层24'上沉积Mo/Al/Mo金属层，再经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对金属层进行图案化，形成源漏极25'以及电容。在源漏极25'上沉积SiOX作为第一保护层11(即钝化层)，再经由曝光、显影、刻蚀、剥膜等工艺对钝化层进行图案化，以对源漏极25'进行保护。

[0066] 因此，本发明通过量子点光致转换层4能够将WOLED电致发光功能层5中短波长部分的蓝光利用量子点发光材料的光致发光特性转换成红光或绿光，以增加显示面板对WOLED电致发光功能层5的能量利用效率，同时提高显示面板的色域表现，并降低显示面板的功耗。

[0067] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，包括：
基板；
薄膜晶体管，设置在所述基板上，在所述薄膜晶体管上设置第一保护层以保护所述薄膜晶体管内部结构；

WOLED彩膜层(WOLED-CF)，设置在所述第一保护层上，所述WOLED彩膜层依次设置红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层上设置第二保护层；
量子点光致转换层，设置在所述第二保护层上，所述量子点光致转换层包括对应所述红绿(RG)像素设置的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层上设置树脂层或平坦层；
第一电极，设置在所述树脂层或所述平坦层上，并在所述第一电极上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域；
WOLED电致发光功能层，设置在所述第一电极上并对应所述量子点光致转换层设置；及
第二电极，设置在所述WOLED电致发光功能层上，其中通过所述量子点光致转换层的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料将所述WOLED电致发光功能层的蓝光或黄光转换成红光和绿光，从而提升所述红色像素和所述绿色像素的亮度。
- [权利要求 2] 如权利要求1所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，其中所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料对应所述WOLED彩膜层的所述红绿(RG)像素设置，而所述WOLED彩膜层的所述蓝白(BW)像素对应所述量子点光致转换层为空白，其中所述量子点光致转换层为量子点增强薄膜(QD-EF)。
- [权利要求 3] 如权利要求1所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，其中所述WOLED电致发光功能层包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合，所述W

OLED电致发光功能层包含2叠层或3叠层结构，且为正置或倒置结构。

- [权利要求 4] 如权利要求1所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，其中所述WOLED电致发光功能层包括空穴注入层(HIL: HATCN)、空穴传输层(HTL: NPB)、蓝色发光层(B-EML: FIrpic)、电荷传输层(TPBi)、电荷产生层(BPhen:Li)、空穴产生层(HATCN)、黄光发光层(Y-EML: PO-48)和电荷注入层(Liq)。
- [权利要求 5] 如权利要求1所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，其中还包括防护玻璃(CG)及封装材料，所述防护玻璃盖设在所述第二电极上方，所述封装材料贴合并封装所述基板和所述防护玻璃，所述封装材料与所述WOLED电致发光功能层、所述量子点光致转换层和所述防护玻璃垂直，所述薄膜晶体管还包括栅极、层叠在所述栅极上的栅极绝缘层、有源层、绝缘遮蔽层以及源漏极，所述第一保护层设置在所述源漏极上，其中所述第一保护层为树脂材料，及所述薄膜晶体管为底栅(BG)TFT结构。
- [权利要求 6] 如权利要求1所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，其中所述薄膜晶体管还包括设置在所述基板上的遮蔽层、缓冲层、有源层、栅极绝缘层、栅极、层间绝缘层以及源漏极，其中所述第一保护层设置于所述层间绝缘层上且以氧化硅(SiO_x)作为钝化层，及所述薄膜晶体管为双栅(DG)TFT结构。
- [权利要求 7] 如权利要求1所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板，其中所述第一电极上还设置有空白层或像素限定层，所述空白层或所述像素限定层邻接所述WOLED电致发光功能层。
- [权利要求 8] 一种显示装置，包括：
基板；
薄膜晶体管，设置在所述基板上，在所述薄膜晶体管上设置第一保护层以保护所述薄膜晶体管内结构；

WOLED彩膜层(WOLED-CF)，设置在所述第一保护层上，所述WOLED彩膜层依次设置红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层上设置第二保护层；

量子点光致转换层，设置在所述第二保护层上，所述量子点光致转换层包括对应所述红绿(RG)像素设置的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层上设置树脂层或平坦层；

第一电极，设置在所述树脂层或所述平坦层上，并在所述第一电极上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域；

WOLED电致发光功能层，设置在所述第一电极上并对应所述量子点光致转换层设置；

第二电极，设置在所述WOLED电致发光功能层上，其中通过所述量子点光致转换层的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料将所述WOLED电致发光功能层的蓝光或黄光转换成红光和绿光，从而提升所述红色像素和所述绿色像素的亮度，及

偏光层，所述偏光层设置在所述基板的另一侧面上。

[权利要求 9] 如权利要求8所述的显示装置，其中所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料对应所述WOLED彩膜层的所述红绿(RG)像素设置，而所述WOLED彩膜层的所述蓝白(BW)像素对应所述量子点光致转换层为空白，其中所述量子点光致转换层为量子点增强薄膜(QD-EF)。

[权利要求 10] 如权利要求8所述的显示装置，其中所述WOLED电致发光功能层包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合，所述WOLED电致发光功能层包含2叠层或3叠层结构，且为正置或倒置结构。

[权利要求 11] 如权利要求8所述的显示装置，其中所述WOLED电致发光功能层包括空穴注入层(HIL: HATCN)、空穴传输层(HTL: NPB)、蓝色发光层(B-EML: FIrpic)、电荷传输层(TPBi)、电荷产生层(BPhen:Li)、空穴产生层(HATCN)、黄光发光层(Y-EML: PO-48)和电荷注入层(Liq)。

- [权利要求 12] 如权利要求8所述的显示装置，还包括防护玻璃(CG)及封装材料，所述防护玻璃盖设在所述第二电极上方，所述封装材料贴合并封装所述基板和所述防护玻璃，所述封装材料与所述WOLED电致发光功能层、所述量子点光致转换层和所述防护玻璃垂直，所述薄膜晶体管还包括栅极、层叠在所述栅极上的栅极绝缘层、有源层、绝缘遮蔽层以及源漏极，所述第一保护层设置在所述源漏极上，其中所述第一保护层为树脂材料，及所述薄膜晶体管为底栅(BG)TFT结构。
- [权利要求 13] 如权利要求8所述的显示装置，其中所述薄膜晶体管还包括设置在所述基板上的遮蔽层、缓冲层、有源层、栅极绝缘层、栅极、层间绝缘层以及源漏极，其中所述第一保护层设置于所述层间绝缘层上且以氧化硅(SiO_x)作为钝化层，及所述薄膜晶体管为双栅(DG)TFT结构。
- [权利要求 14] 如权利要求8所述的显示装置，其中所述第一电极上还设置有空白层或像素限定层，所述空白层或所述像素限定层邻接所述WOLED电致发光功能层。
- [权利要求 15] 一种底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，包括以下步骤：
- S10、提供基板；
- S20、在基板上制作形成所述薄膜晶体管，以及在所述薄膜晶体管上形成第一保护层；
- S30、在所述第一保护层上形成WOLED彩膜层(WOLED-CF)，所述WOLED彩膜层依次形成红绿蓝白(RGBW)像素并在所述WOLED彩膜层上形成第二保护层；
- S40、在所述第二保护层上形成量子点光致转换层(QD-PL conversion layer)，所述量子点光致转换层包括对应所述红绿(RG)像素填充的量子点红绿(QD-R&G)发光材料，在所述量子点光致转换层上形成树脂层或平坦层；
- S50、在所述树脂层或平坦层上形成第一电极，并在所述第一电极上定义出红绿蓝白(RGBW)像素区域；

S60、在所述第一电极上形成WOLED电致发光功能层并对应所述量子点光致转换层设置；及

S70、在所述WOLED电致发光功能层上形成第二电极，其中通过所述量子点光致转换层的所述量子点红绿(QD-R&G)发光材料将所述WOLED电致发光功能层的蓝光或黄光转换成红光和绿光，从而提升所述红色像素和所述绿色像素的亮度。

- [权利要求 16] 如权利要求15所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，其中，在步骤S40中，所述量子点光致转换层通过喷墨打印、喷嘴印刷或转移成型工艺制成，所述量子点光致转换层还将量子点红绿(QD-R&G)发光材料填充在相应的红绿(RG)像素区域中，所述量子点红绿发光材料则不填充于蓝白(BW)像素区域中，所述量子点光致转换层为量子点增强薄膜(QD-EF，且厚度为10-200奈米(nm)。
- [权利要求 17] 如权利要求15所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，其中，在步骤S60中，所述WOLED电致发光功能层包含蓝光+黄光、蓝光+红光+黄光、蓝光+红光+黄光+绿光或蓝光+红光+绿光光色中任一组合。
- [权利要求 18] 如权利要求15所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，其中，在步骤S60后，在所述第一电极上还形成有空白层或像素限定层，所述空白层或所述像素限定层邻接所述WOLED电致发光功能层，并定义所述红绿蓝白(RGBW)像素区域。
- [权利要求 19] 如权利要求15所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，其中，在步骤S30中，包括在所述薄膜晶体管上涂布树脂材料或沉积氧化硅并通过显影、曝光形成图案化，以形成所述第一保护层。
- [权利要求 20] 如权利要求15所述的底发射白光有机发光二极管(WOLED)显示面板的制作方法，其中，在步骤S70后，还包括盖设在所述第二电极上方的防护玻璃(CG)以及贴合并封装所述基板和所述防护玻璃的封装材料，所述封装材料通过阻塞封装、阻塞填入封装、熔块封装、面密封封

装或薄膜封装。

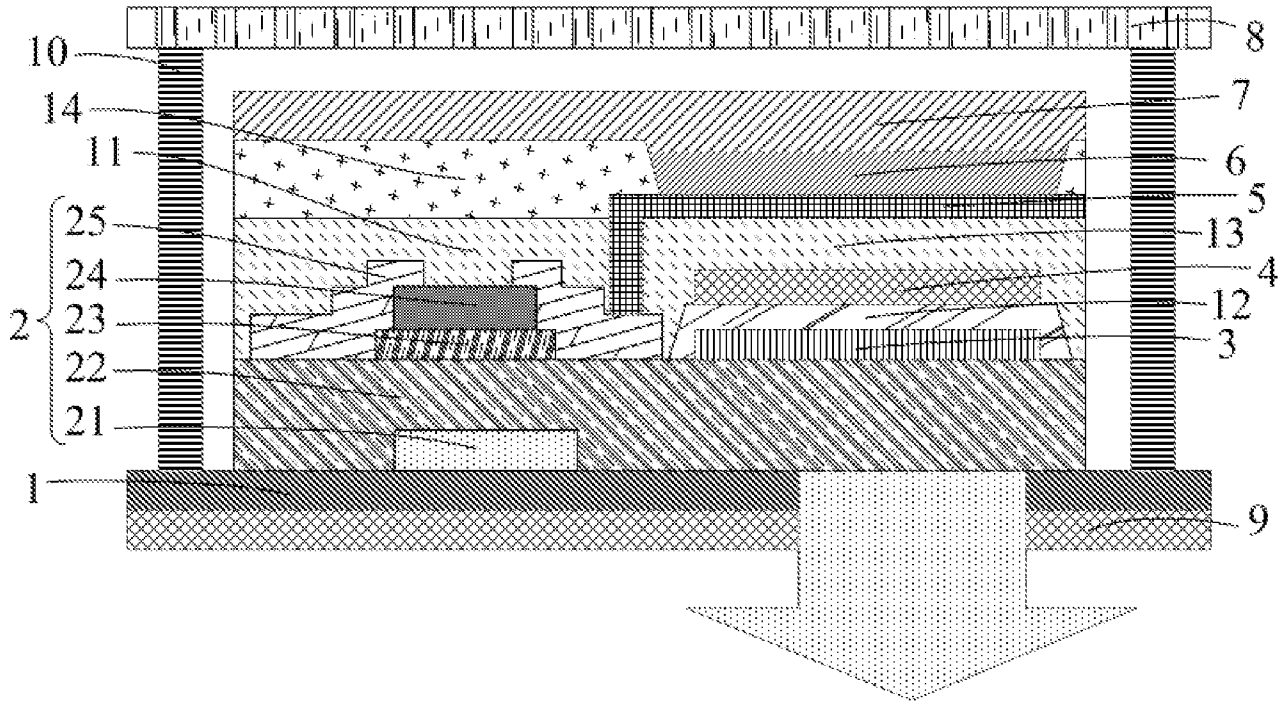


图 1

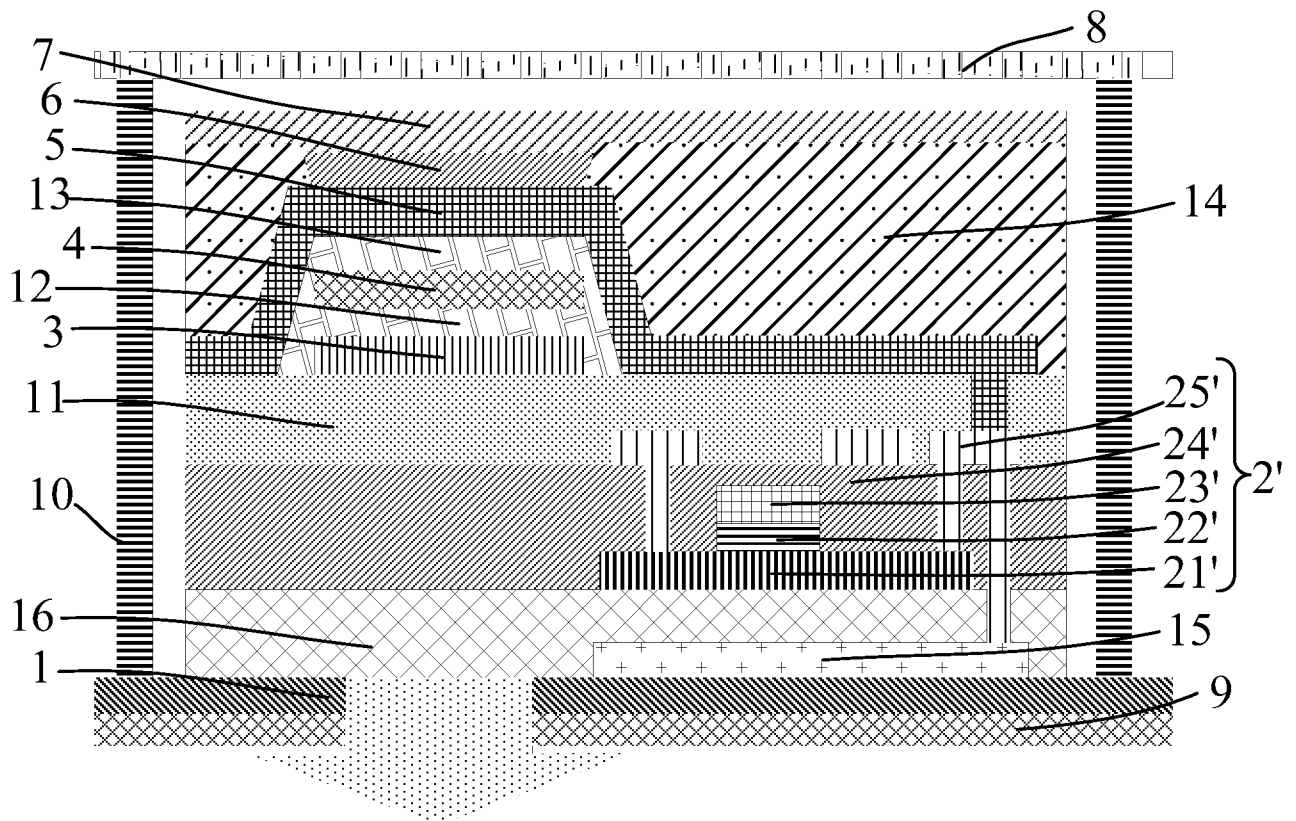


图 2

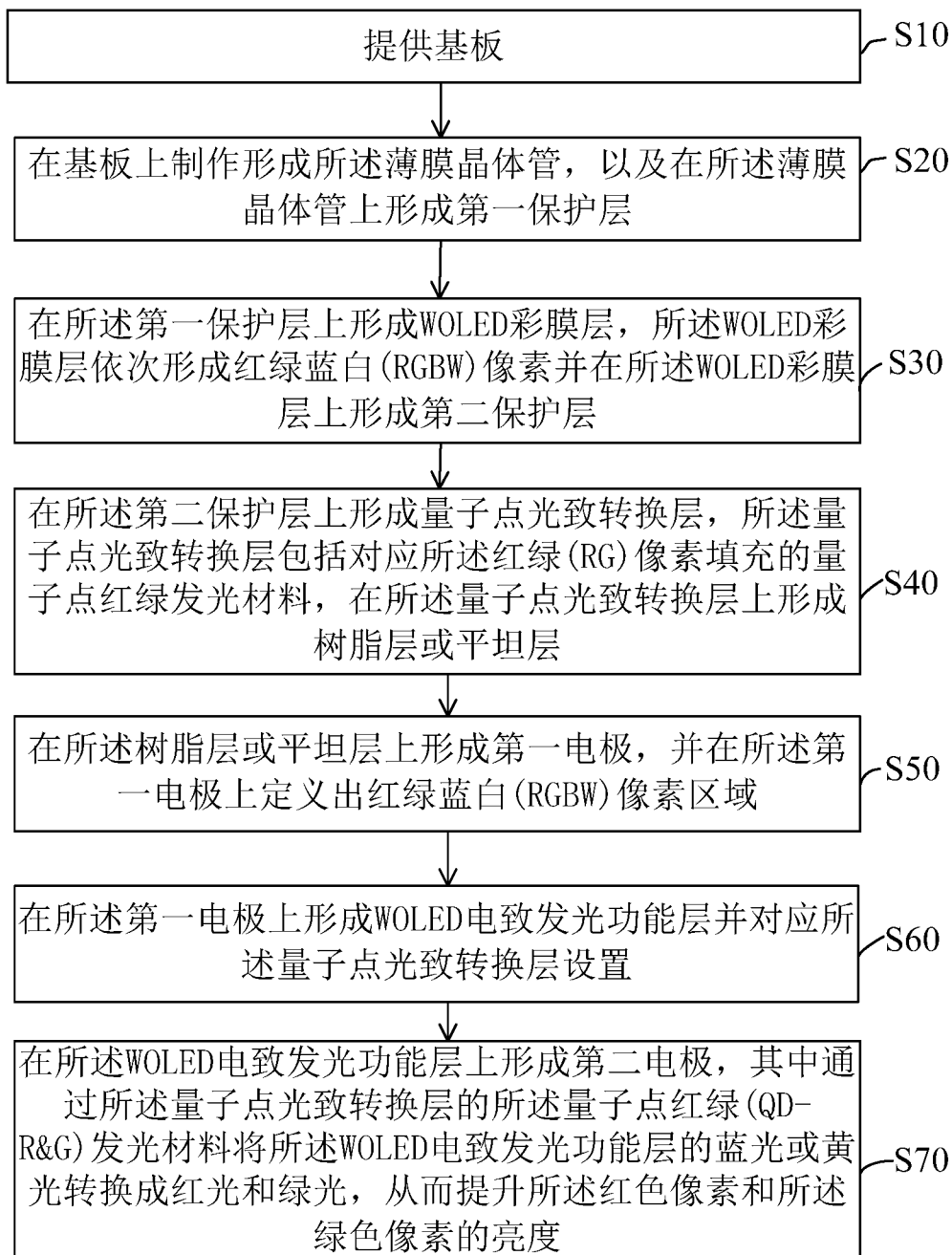


图 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/080870

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01L 51/50(2006.01)i; H01L 51/52(2006.01)i; H01L 51/56(2006.01)i; H01L 27/32(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNKI; CNABS; DWPI; SIPOABS: 光致转换, 光转换, 彩膜, 显示面板, 薄膜晶体管, 红绿, light converting, light transfer???, color film, colour film, display panel, thin film transistor, TFT, red green

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 104201187 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.) 10 December 2014 (2014-12-10) description, paragraphs 0025-0032, and figure 1	1-20
A	CN 108987451 A (BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.) 11 December 2018 (2018-12-11) entire document	1-20
A	US 2017131594 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB) 11 May 2017 (2017-05-11) entire document	1-20
A	CN 107910347 A (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.) 13 April 2018 (2018-04-13) entire document	1-20



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 November 2019

Date of mailing of the international search report

03 December 2019

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing
100088
China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2019/080870

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	104201187	A	10 December 2014	WO	2016026220	A1	25 February 2016
				EP	3185298	A4	28 February 2018
				US	2016293100	A1	06 October 2016
				US	9892675	B2	13 February 2018
				CN	104201187	B	04 July 2017
				EP	3185298	A1	28 June 2017
CN	108987451	A	11 December 2018	None			
US	2017131594	A1	11 May 2017	WO	2017081575	A1	18 May 2017
				TW	201723622	A	01 July 2017
				US	9964800	B2	08 May 2018
				JP	2017090916	A	25 May 2017
CN	107910347	A	13 April 2018	WO	2019075815	A1	25 April 2019
				US	2019115408	A1	18 April 2019
				US	10340322	B2	02 July 2019

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2019/080870

A. 主题的分类 H01L 51/50(2006.01)i; H01L 51/52(2006.01)i; H01L 51/56(2006.01)i; H01L 27/32(2006.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																	
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) H01L 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNKI; CNABS; DWPI; SIPOABS: 光致转换, 光转换, 彩膜, 显示面板, 薄膜晶体管, 红绿, light converting, light transfer???, color film, colour film, display panel, thin film transistor, TFT, red green																	
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>CN 104201187 A (京东方科技集团股份有限公司) 2014年 12月 10日 (2014 - 12 - 10) 说明书第0025段至0032段, 图1</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 108987451 A (京东方科技集团股份有限公司) 2018年 12月 11日 (2018 - 12 - 11) 全文</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 2017131594 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB) 2017年 5月 11日 (2017 - 05 - 11) 全文</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 107910347 A (深圳市华星光电半导体显示技术有限公司) 2018年 4月 13日 (2018 - 04 - 13) 全文</td> <td>1-20</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	X	CN 104201187 A (京东方科技集团股份有限公司) 2014年 12月 10日 (2014 - 12 - 10) 说明书第0025段至0032段, 图1	1-20	A	CN 108987451 A (京东方科技集团股份有限公司) 2018年 12月 11日 (2018 - 12 - 11) 全文	1-20	A	US 2017131594 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB) 2017年 5月 11日 (2017 - 05 - 11) 全文	1-20	A	CN 107910347 A (深圳市华星光电半导体显示技术有限公司) 2018年 4月 13日 (2018 - 04 - 13) 全文	1-20
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求															
X	CN 104201187 A (京东方科技集团股份有限公司) 2014年 12月 10日 (2014 - 12 - 10) 说明书第0025段至0032段, 图1	1-20															
A	CN 108987451 A (京东方科技集团股份有限公司) 2018年 12月 11日 (2018 - 12 - 11) 全文	1-20															
A	US 2017131594 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB) 2017年 5月 11日 (2017 - 05 - 11) 全文	1-20															
A	CN 107910347 A (深圳市华星光电半导体显示技术有限公司) 2018年 4月 13日 (2018 - 04 - 13) 全文	1-20															
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																	
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																	
国际检索实际完成的日期 2019年 11月 21日		国际检索报告邮寄日期 2019年 12月 3日															
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		受权官员 刘红 电话号码 86-010-62089538															

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/080870

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	104201187	A	2014年 12月 10日	WO	2016026220	A1	2016年 2月 25日
				EP	3185298	A4	2018年 2月 28日
				US	2016293100	A1	2016年 10月 6日
				US	9892675	B2	2018年 2月 13日
				CN	104201187	B	2017年 7月 4日
				EP	3185298	A1	2017年 6月 28日
CN	108987451	A	2018年 12月 11日	无			
US	2017131594	A1	2017年 5月 11日	WO	2017081575	A1	2017年 5月 18日
				TW	201723622	A	2017年 7月 1日
				US	9964800	B2	2018年 5月 8日
				JP	2017090916	A	2017年 5月 25日
CN	107910347	A	2018年 4月 13日	WO	2019075815	A1	2019年 4月 25日
				US	2019115408	A1	2019年 4月 18日
				US	10340322	B2	2019年 7月 2日